#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## | 1110 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 111

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Januar 2002 (17.01.2002)

#### **PCT**

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/05360 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 51/40

H01L 51/20,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/02377

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Juni 2001 (27.06.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 33 112.2

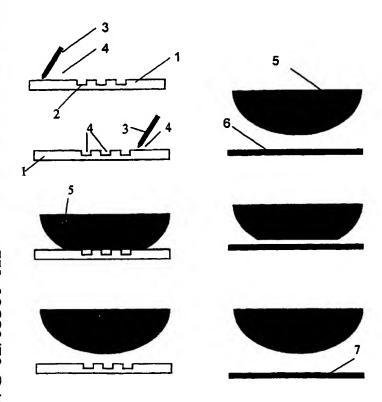
7. Juli 2000 (07.07.2000) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). BERNDS, Adolf [DE/DE]; Adalbert-Stifter-Str. 11, 91083 Baiersdorf (DB). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Mühlstr. 20 a, 90762 Fürth (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DB).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION AND CONFIGURATION OF ORGANIC FIELD-EFFECT TRANSISTORS (OFET)

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND STRUKTURIERUNG ORGANISCHER-FELDEFFEKT-TRAN-SISTOREN (OFET)



- (57) Abstract: The invention relates to an economical and precise method for the production and configuration of OFETs, whereby the solubility of at least one functional polymer of an OFET is utilised to such a degree, that the functional polymer is deposited on the OFET, or a substrate, by means of a conventional printing process as for a colour.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung stellt ein kostengünstiges und präzises Verfahren zur Herstellung und Strukturierung von OFETs zur Verfügung, indem die Löslichkeit zumindest eines Funktionspolymers eines OFETs insofern ausgenützt wird, als das Funktionspolymer wie eine Farbe mit einem herkömmlichen Druckverfahren auf das vorbereitete OFET oder ein Substrat aufgebracht wird.



- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

1

Verfahren zur Herstellung und Strukturierung organischer-Feldeffekt-Transistoren (OFET)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung und Strukturierung organischer Feldeffekt-Transistoren (OFETs).

Polymere integrierte Schaltkreise (integrated circuits) auf der Basis von OFETs werden für mikroelektronische Massenan-wendungen und Wegwerf-Produkte wie Identifikations- und Produkt-"tags" gebraucht. Ein "tag" ist z.B. ein elektronischer Streifencode, wie er auf Waren angebracht wird oder auf Koffern. Dabei kann auf das excellente Betriebsverhalten der Silizium-Technologie verzichtet werden, aber dafür sollten niedrige Herstellungkosten und mechanische Flexibilität gewährleistet sein. Die Bauteile wie z.B. elektronische Strich-Kodierungen, sind typischerweise Einwegeprodukte und sind wirtschaftlich nur interessant, wenn sie in preiswerten Prozessen hergestellt werden.

Bisher wird, wegen der Herstellungskosten, nur die Leiterschicht des OFETs strukturiert, da die Strukturierung nur über einen zweistufigen Prozess ("Lithographiemethode" vgl dazu Applied Physics Letters 73(1),1998, S.108.110 und Mol.Cryst.Liq. Cryst. 189,1990, S.221-225) mit zunächst vollflächiger Beschichtung und darauffolgender Strukturierung, die zudem materialspezifisch ist, bewerkstelligt werden kann. Mit "Materialspezifität" ist gemeint, dass der beschriebene Prozess mit den genannten photochemischen Komponenten einzig an dem leitfähigen Polymer Polyanilin funktioniert. Ein anderes leitfähiges Polymer, z.B. Polypyrrol, läßt sich so nicht ohne weiteres strukturieren.

Die fehlende Strukturierung der anderen Schichten, wie der halbleitenden und der isolierenden Schicht aus Funktionspolymeren führt zu einer deutlichen Leistungssenkung der erhaltenen OFETs, darauf wird aber aus Kostengründen verzichtet.

Aufgabe der Erfindung ist daher ein kostengünstiges und massenfertigungstaugliches Verfahren zur Herstellung und Strukturierung von OFETs zur Verfügung zu stellen und einen leistungsstärkeren, weil mit mehr strukturierten Schichten ausgestatteten, OFET.

Gegenstand der Erfindung ist ein Organischer Feld-Effekt-Transistor (OFET), zumindest folgende Schichten auf einem Substrat umfassend:

- 10 eine halbleitende Schicht zwischen einer Source- und einer Drain-Elektrode
  - eine Isolationsschicht auf über der halbleitenden
     Schicht und
  - eine Leiterschicht,
- wobei die Leiterschicht und zumindest eine der beiden anderen Schichten strukturiert ist. Ausserdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung und Strukturierung eines OFETs durch Drucken von zumindest einem Funktionspolymer auf ein Substrat, wobei das Funktionspolymer zunächst in eine farbähnliche Konsistenz gebracht und dann auf das Substrat aufgedruckt wird.

Mit "farbähnliche Konsistenz" ist gemeint, dass die zu druckenden Funktionspolymere mit herkömmlichen Druckfarben in

25 bezug auf

5

- Viskosität der druckfertigen Mischung (bestimmt das Fließverhalten)
- Polymerkonzentration der druckfertigen Mischung (bestimmt die Schichtdicke)
- Siedetemperatur des Lösungsmittels (bestimmt welches Druckverfahren einsetzbar ist) und
  - Oberflächenspannung der druckfertigen Mischung (bestimmt die Benetzungsfähigkeit des Substrats oder anderer Schichten)
- 35 vergleichbar sind.

Prinzipiell sind alle Druckverfahren, mit denen Farbbilder erzeugt werden, auch zur Herstellung von OFETs geeignet. Es ist jedoch zu beachten, dass eine genügend hohe Ausflösung im um-Bereich erzielt wird.

3

Beim Tampondruck mit Silicontampons wird eine hohe Auflösung erzielt, die zur Strukturierung im µm-Bereich geeignet ist.

Vorteilhafterweise werden die Funktionspolymere durch Ein10 bringen in Lösungsmittel in eine farbähnliche Konsistenz gebracht. Beispielsweise werden aus folgenden Funktionspolymere
mit folgenden Lösungmitteln druckfertige Mischungen hergestellt:

Polyanilin (elektr. Leiter) wird in m-Kresol gelöst;
15 Polythiophen (Halbleiter) in Chloroform und
Polyvinylphenol (Isolator) in Dioxan.

Nach einer Ausgestaltung wird zunächst zumindest ein gelöstes Funktionspolymer mit einem Rakel in ein "Negativ" der aufzudruckenden Schicht gefüllt. Mit Hilfe eines Tampons (z.B. aus Silicon) wird das geformte Funktionspolymer dann aus der Negativform, die auch Klischee genannt wird, abgenommen und auf das Substrat und gegebenenfalls dort auf fertige Schichten aufgebracht.

25

20

5

Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens findet die Herstellung im kontinuierlichen Verfahren statt, so dass z.B. eine Tamponrolle zunächst über ein Klischee rollt und dort das Funktionspolymer auflädt und im weiteren kontinierlichen Verlauf über ein Substrat rollt, auf das es das Funktionspolymer wieder ablädt, danach rollt es wieder über ein Klischee und dann wieder über ein Substrat.

Je nach Klischee können damit auch verschiedene Strukturie-35 rungsprozesse in einem Umlauf einer grossen Tamponrolle untergebracht werden.

4

Als Funktionspolymere können elektrische Leiter (z.B. Polyanilin), Halbleiter (z.B. Polythiophen) und Isolatoren (z.B. Polyvinylphenol) eingesetzt werden.

5 Durch das Drucken werden gleichzeitig Schichtaufbau und Strukturierung des OFETs realisiert.

Im folgenden soll die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.

10

In den Figuren 1 bis 7 werden die einzelnen Prozessschritte eines Tampondrucks im kontinuierlichen Verfahren mit einer Tamponrolle gezeigt.

In Figur 1 ist zunächst das Klischee 1 mit den Negativen 2 der aufzubringenden Struktur gezeigt. Vor den Negativ. Abdrücken ist ein Rakel 3 zu erkennen, das das Funktionspolymer 4 dem Klischee entlang rakelt. In Figur 2 ist das Negativ 2 des Klischees mit Funktionspolymer 4 gefüllt und das Rakel gleitet gerade mit dem Rest an Polymer auf dem Klischee 1, das sich beispielsweise drehen kann, weiter. In Figur 3 erkennt man die grosse Tamponrolle 5, die vom Klischee 3 das fertig strukturierte Funktionspolymer 4 aufnimmt und (vgl Figuren 4 bis 7) auf ein Substrat 6 abbildet. In Figur 7 ist das fertig aufgebrachte und strukturierte OFET 7 zu sehen.

Die Erfindung stellt ein kostengünstiges und präzises Verfahren zur Herstellung und Strukturierung von OFETs zur Verfügung, indem die Löslichkeit zumindest eines Funktionspolymers eines OFETs insofern ausgenützt wird, als das Funktionspolymer wie eine Farbe mit einem herkömmlichen Druckverfahren auf das vorbereitete OFET oder ein Substrat aufgebracht wird. Das Herstellungsverfahren kann zum kostengünstigen Fertigen von Produkt- und/oder Identifikations tags eingesetzt werden.

35

30

Im Gegensatz zu der herkömmlichen Methode, mit denen lediglich die Leiterschicht eines OFETs strukturiert werden kann

5

und die anderen Schichten des OFETs unstrukturiert bleiben, ist der Druckprozess, den die Erfindung vorschlägt, nicht materialspezifisch, d.h. es kann jedes beliebige leitfähige Polymer gedruckt werden. Also sowohl Polyanilin als auch Polypyrrol und weitere leitfähige Polymere können mit Hilfe des Druckverfahrens auf das Substrat zur Bildung des OFETs strukturiert werden. Die "Lithographiemethode" macht aus Kostengründen keinen Sinn für die Strukturierung der nicht leitfähigen Schichten des organischen Transistors (Halbleiter und Isolator). Hier kommt mangels anderer Strukturierungsverfahren eigentlich nur das Drucken gemäß der Erfindung in Frage.

10

6

#### Patentansprüche

- 1. Organischer Feld-Effekt-Transistor, zumindest folgende Schichten auf einem Substrat umfassend:
- 5 eine halbleitende Schicht zwischen einer Source- und einer Drain-Elektrode
  - eine Isolationsschicht auf über der halbleitenden Schicht und
  - eine Leiterschicht,
- 10 wobei die Leiterschicht und zumindest eine der beiden anderen Schichten strukturiert ist.
  - 2. Verfahren zur Herstellung eines OFETs durch Drucken von zumindest einem Funktionspolymer auf ein Substrat, wobei das
- 15 Funktionspolymer zunächst in eine farbähnliche Konsistenz gebracht und dann auf das Substrat aufgedruckt wird.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem ein Druckverfahren, mit dem Farbbilder erzeugt werden können, unter Verwendung eines Funktionspolymers statt einer Farbe eingesetzt wird.
  - 4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 2 oder 3, bei dem ein Tampondruckverfahren eingesetzt wird.
- 5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 2 bis 4, bei dem ein Tampon aus Silicon eingesetzt wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 2 bis 5, bei dem eine Tamponrolle in einem kontinuierlichen Prozess
   eingesetzt wird.
  - 7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 2 bis 6, bei dem das Funktionspolymer durch Einbringen in ein Lösungsmittel in eine farbähnliche Konsistenz gebracht wird.

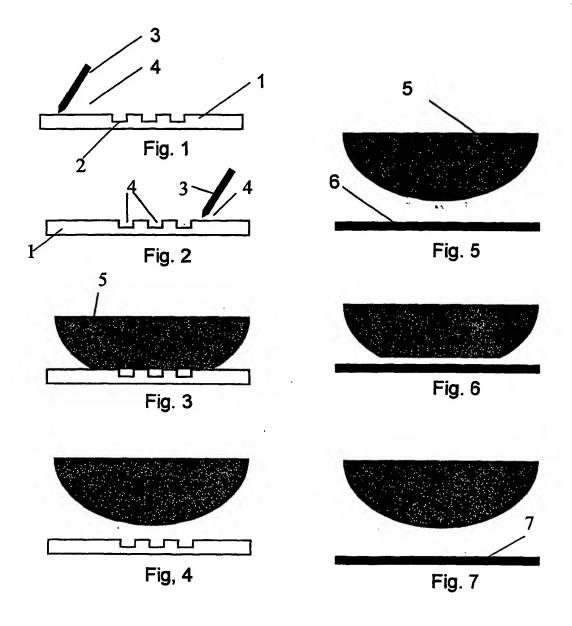
20

7

- 8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche 2 bis 7, bei dem eine Auflösung und/oder Strukturierung im µm-Bereich realisiert wird.
- 5 9. Verwendung eines OFETs nach Anspruch 1 zur Herstellung eines Identifikations- und/oder Produkt-"tags".

10

10. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 2 bis 8 zur Herstellung von Identifikations- und Produkt-"tags".



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter nal Application No PCT7DE 01/02377

		101702	)1/023//
A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20 H01L51/40		
Accordina to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification H01L	n symbols)	
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the field	s searched
	ata base consulted during the international search (name of data bas ternal, INSPEC, PAJ	se and, where practical, search terms u	sed)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198-51 703 A (INST HALBLEITERF GMBH) 4 May 2000 (2000-05-04) figure 3	PHYSIK-	1.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07, 31 July 1997 (1997-07-31) & JP 09 083040 A (SHARP CORP), 28 March 1997 (1997-03-28) abstract		1
X	WO 99 39373 A (UNIV PRINCETON) 5 August 1999 (1999-08-05) page 10, line 29 -page 11, line 8 14A,B	3; figures	2,3,7
		-/	
	· ·		
X Fun	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are II	sted in annex.
"A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which citatic "O" docum other	ategories of cited documents:  ant defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the International date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)  ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"T later document published after the or priority date and not in conflict cited to understand the principle invention."  "X" document of particular relevance; cannot be considered novel or call involve an inventive step when the "Y" document of particular relevance; cannot be considered to involve a document is combined with one of ments, such combination being of in the art.  "&" document member of the same particular results."	with the application but or theory underlying the the claimed invention nnot be considered to e document is taken alone the claimed invention an inventive step when the or more other such docu- by lous to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the International	d search report
	23 October 2001_	30/10/2001	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer.  Königstein, C	

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter nal Application No
PCT/DE 01/02377

		PCT/DE 01/	02377	
C.(Continua	ntion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
X	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 11, no. 9, 5 July 1999 (1999-07-05), pages 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 the whole document		2,3,7	
<b>A</b>	GARNIER F ET AL: "ALL-POLYMER FIELD-EFFECT TRANSISTOR REALIZED BY PRINTING TECHNIQUES" SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, vol. 265, 16 September 1994 (1994-09-16), pages 1684-1686, XP000783907 ISSN:-0036-8075 the whole document	·	_	
	·			
	·			
		,		
			;	
	·			
	<b>1</b> .		·	

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

Inter nal Application No
PCT7DE 01/02377

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19851703	A	04-05-2000	DE	19851703 A1	04-05-2000
JP 09083040	Α	28-03-1997	NONE		
WO 9939373	A	05-08-1999	US AU EP WO	6087196 A 2481599 A 1051738 A2 9939373 A2	11-07-2000 16-08-1999 15-11-2000 05-08-1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzeichen
PCT7DE 01/02377

A. KLASSII IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20 H01L51/40	. ———			
Nach der Int	ernationaten Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK			
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier IPK 7	ler Mindestprüfstoff (Klassiffikationssystem und Klassifikationssymbo H01L	ole )			
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Geblete	fallen		
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)		
EPO-In	EPO-Internal, INSPEC, PAJ				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
<b>-X</b> .	DE 198 51 703 A (INST HALBLEITERF GMBH) 4. Mai 2000 (2000-05-04) Abbildung 3	PHYSIK	. 1-		
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07, 31. Juli 1997 (1997-07-31) & JP 09 083040 A (SHARP CORP), 28. Mārz 1997 (1997-03-28) Zusammenfassung				
X	WO 99 39373 A (UNIV PRINCETON) 5. August 1999 (1999-08-05) Seite 10, Zeile 29 -Seite 11, Zei Abbildungen 14A,B	ile 8; -/	2,3,7		
Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen					
*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist					
'E' älteres i Anmel	E* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmektedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung				
*C* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritalsanspruch zweifelnatt er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdalum eher anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgerißhrt)  *O* Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung,  *O* Veröffentlichung dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wann die Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung oberacht wird und					
*P* Veröffer	eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Mathahmen bezieht  "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Annenbledatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist  "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist				
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
<u>. 2</u> :	<u>3.</u> Oktober 20 <u>01</u>	30/10/2001			
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter.Bediensteter .			
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C			

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzeichen
PCT7DE 01/02377

		1/DE 01/023//
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Telle Betr. Anspruch Nr.
X	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 11, Nr. 9, 5. Juli 1999 (1999-07-05), Seiten 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument	2,3,7
A	GARNIER F ET AL: "ALL-POLYMER FIELD-EFFECT TRANSISTOR REALIZED BY PRINTING TECHNIQUES" SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, Bd. 265, 16. September 1994 (1994-09-16), Seiten 1684-1686, XP000783907 - ISSN: -0036-8075 das ganze Dokument	
		,
		- ·

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich

tle zur seiben Patentfamilie gehören

inter ales Aktenzelchen
PCT7DE 01/02377

	echerchenbericht rtes Patentdokumen	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	19851703	· A	04-05-2000	DE	19851703 A1	04-05-2000
JP	09083040	A	28-03-1997	KEINE		
WO	9939373	A	05-08-1999	US AU EP WO	6087196 A 2481599 A 1051738 A2 9939373 A2	11-07-2000 16-08-1999 15-11-2000 05-08-1999

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
(	☐ BLACK BORDERS		
[	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
ľ	FADED TEXT OR DRAWING		
[	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
[	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
(	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
(	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
[	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
Į	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.